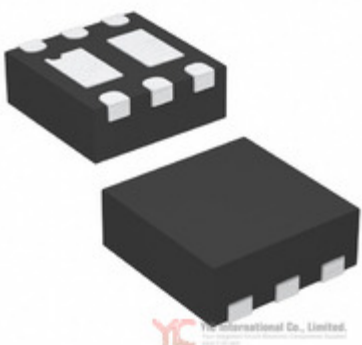

	<h2 style="color: #E67E22;">SIA810DJ-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIA810DJ-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 4.5A SC70-6
	Datenblätter:  SIA810DJ-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

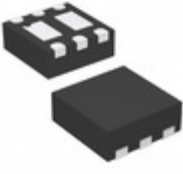
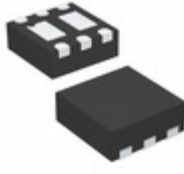
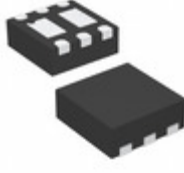
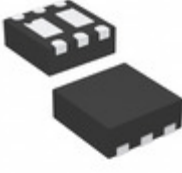
Spezifikationen

Teilenummer	SIA810DJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 4.5A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	53 mOhm @ 3.7A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta), 6.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	15 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.5nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 4.5A (Tc) 1.9W (Ta), 6.5W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)

SIA810DJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA810DJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA810DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA810DJ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA811ADJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.5A PPAK SC70-6</p>	 <p>SIA811DJ-T1 VISHAY SIA811DJ-T1 VISHAY</p>	 <p>SIA811ADJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.5A PPAK SC70-6</p>	 <p>SIA811DJ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>
 <p>SIA810DJ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA811DJ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA810DJ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 4.5A SC70-6</p>	 <p>SIA778DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 12V/20V SC70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA810DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / SIA810DJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA810DJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA810DJ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIA810DJ-T1-GE3
SIA810DJ-T1-GE3 Electronic	SIA810DJ-T1-GE3-Komponenten	SIA810DJ-T1-GE3-Verteiler	SIA810DJ-T1-GE3-Bild
SIA810DJ-T1-GE3 Preis	SIA810DJ-T1-GE3 Hersteller	SIA810DJ-T1-GE3 Bild	SIA810DJ-T1-GE3 Aktie
SIA810DJ-T1-GE3 Neu	SIA810DJ-T1-GE3 Original	SIA810DJ-T1-GE3 garantiert	SIA810DJ-T1-GE3 RFQ
			SIA810DJ-T1-GE3 Inventar
			SIA810DJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited